(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-21920

(43)公開日 平成9年(1997)1月21日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G02B	6/12			G 0 2 B	6/12	N	
	6/13			C 0 8 G	73/10		
# C08G	73/10			G 0 2 B	6/12	M	

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全 13 頁)

		音画的水 木明水 明水気の取り トレ (土 13	Ą)
(21)出顧番号	特顯平7-194040	(71) 出願人 000004226	
		日本電信電話株式会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)7月7日	東京都新宿区西新宿三丁目19番2号	
		(72) 発明者 松浦 徹	
		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号	日
		本電信電話株式会社内	
		(72)発明者 小勝負 信建	
		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号	日
		本電信電話株式会社内	
		(72) 発明者 丸野 透	
		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号	Ħ
		本電信電話株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外2名)	•
		最終頁に記	老く

(54) 【発明の名称】 ポリイミド光導波路

(57)【要約】

【課題】 偏波方向に対する光損失等の光導波特性の相 違が小さいという特性を有する基板上のポリイミド光導 波路を提供する。

【解決手段】 コア層及びクラッド層がポリイミドであって、このポリイミドの基板面と平行な方向の屈折率(nte)と基板面に垂直な方向の屈折率(ntm)の差(nte-ntm)の相違が、波長1.3μmにおいて0.003以下であるポリイミドから構成されるポリイミド光導波路。コア層とクラッド層の一方又は両方が、2種類以上のポリイミドの共重合体であって、nte-ntmの相違が共重合比によらず波長1.3μmにおいて0.03以下であるポリイミドとポリイミド共重合体から構成され、更にポリイミド共重合体の共重合比を変化させることでコアとクラッドの間の屈折率差を制御するポリイミド光導波路。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に積層したコア層とクラッド層からなる光導波路において、上記コア層及びクラッド層がポリイミドであって、このポリイミドの基板面と平行な方向の屈折率(ntw)の差(nte-ntw)の相違が、波長1.3 μmにおいて0.003以下であるポリイミドから構成されることを特徴とするポリイミド光導波路。

【請求項2】 光導波路のコア層又はクラッド層のどちらか一方が、2種類以上のポリイミドの共重合体であって、nte-ntwの相違が共重合比によらず波長1.3μmにおいて0.003以下であるポリイミドとポリイミド共重合体から構成されることを特徴とし、更にポリイミド共重合体の共重合比を変化させることでコアとクラッドの間の屈折率差を制御することを特徴とする請求項1に記載のポリイミド光導波路。

【請求項3】 光導波路のコア層及びクラッド層が共に 2種類以上のポリイミドの共重合体であって、かつnte - ntwの相違が共重合比によらず波長1.3 μ mにおいて0.003以下であるポリイミド共重合体から構成されることを特徴とし、更にその共重合比を変化させることでコアとクラッドの間の屈折率差を制御することを特*

*徴とする請求項1に記載のポリイミド光導波路。

【請求項4】 光導波路に用いるポリイミド共重合体が下記一般式(化1):

2

及び下記一般式(化2):

で表される繰り返しからなるポリイミド共重合体において R_1 及び R_2 がそれぞれ下記式(化3):

【化3】

の屈折率差を制御することを特
$$*$$
 CF_3
 R_1 が CF_3
 R_2 が CF_3
 CF_3
 CF_4
 CF_3
 CF_4
 CF_5
 CF_5

で表される繰り返しからなるポリイミドの共重合体であることを特徴とする請求項2又は3に記載のポリイミド 光導波路。

【請求項5】 光導波路に用いるポリイミド共重合体が下記一般式(化4):

(化4)

及び下記一般式(化5): 【化5】

*で表される繰り返しからなるポリイミドの共重合体であることを特徴とする請求項2又は3に記載のポリイミド

【請求項6】 光導波路に用いるポリイミド共重合体が

光導波路。

【化7】

下記一般式(化7):

$$\begin{bmatrix}
0 & F & F & F & O \\
N & F & F & F & F & O
\end{bmatrix}$$

で表される繰り返しからなるポリイミド共重合体においてRs 及びR4 がそれぞれ下記式(化6):

【化6】

R₃ tr - 0 - 7

 $-\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{F}_3}}-\circ-\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}}$

及び下記一般式(化8):

[(L8])

O F₃ C CF₃ O

O SO₂

O SO₂

で表される繰り返しからなるポリイミドの共重合体であることを特徴とする請求項2又は3に記載のポリイミド 光導波路。 ※【請求項7】 光導波路に用いるポリイミド共重合体が下記一般式(化9):

及び下記一般式(化10):

【化10】

20

で表される繰り返しからなるポリイミドの共重合体であ ることを特徴とする請求項2又は3に記載のポリイミド 光導波路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光導波路に関し、特 に優れた耐熱性に加えて光の偏波方向に対する光損失等 の光導波特性の相違が小さい髙分子光導波路に関する。

[0002]

【従来の技術】低損失光ファイバの開発による光通信シ ステムの実用化に伴い、種々の光通信用部品の開発が望 まれている。またこれら光部品を高密度に実装する光配 線技術、特に光導波路技術の確立が望まれている。これ らの光部品の材料として、これまで光透過性と耐熱性に 優れた石英が主に検討されている。一方、ポリメチルメ タクリレート (PMMA)、ポリスチレン (PS)、ポ リカーボネート (PC) 等の透明性に優れた高分子もま た、①加工性に優れる、②部品の大面積化が可能、③屈 折率を幅広い範囲で制御できる、④柔軟性、耐衝撃性に 優れる等、上記光部品材料として優れた特徴を有してい る。しかし、これらの高分子材料は上記光部品に要求さ れる十分な耐熱性を有していない。そこで、①~④の高 分子としての特徴を有することに加えて、耐熱性に優れ た高分子材料であるポリイミドの光部品への適用が検討 されている。特開平4-9807号公報においては、ポ リイミドを用いた光導波路が基板上に製造できることが 示されている。しかし、光導波路の作製工程において、 ポリイミドは基板への前駆体 (ポリアミド酸) 溶液の塗 布とその後の加熱による硬化収縮や基板との熱膨張率差 により生じる応力のために、その基板面と平行な方向の 屈折率(nte)と基板面に垂直な方向の屈折率(ntw) に相違が生じる。本明細書ではこれ以降、птЕとптиの 差 (nte-ntw) を複屈折と定義して用いることにす る。この複屈折の大きさはコア材のポリイミドとクラッ ド材のポリイミドの間で異なるため、コアとクラッドの 屈折率差が基板面と平行な方向の偏光と基板面に垂直な 方向の偏光で異なることになり、その結果、光導波路に 入射する光の偏光方向により光損失が異なること、すな わち片方の偏光での光損失が増大するという問題があっ た。そこで、本発明者らは特願平6-54376号明細 書において基板上に作製したポリイミド光導波路を基板 からはく離した後、熱処理を行うことでポリイミド光導 波路に生じた応力を解放し、これによって光学異方性が 小さく、光学的に均一な光導波路が作製できることを示

している。しかし、この場合も光導波路から応力を解放 するためには基板を取り除かなければならないという問 題があった。この材料としてのポリイミドは種々の有機 10 ポリマーの中で耐熱性に優れているため、宇宙、航空分 野から電子通信分野まで幅広く使われ始めている。特に 最近では、単に耐熱性に優れているだけでなく、用途に 応じて種々の性能を合せ持つことが期待されている。例 えばプリント板や、LSI用の層間絶縁膜などでは、熱 膨張係数、誘電率が小さいことが期待され、光通信関係 では特に光導波路のクラッド材には屈折率差が小さいこ とが期待されている。また、安定な物性値を保つには、 吸水率の小さなことが必要である。特にポリイミドを光 通信用の光学材料として適用する場合、高い耐熱性に加 えて、優れた光透過性や屈折率の精密な制御性が重要と なる。これまでに優れた耐熱性、光透過性、屈折率制御 性を有するポリイミドが特開平4-8734号公報にお いて明らかにされている。ここでは屈折率の相異なる2 種類のフッ素化ポリイミドの共重合を行い、その共重合 比を変えることで屈折率を制御している。一方、耐熱性 に優れた芳香族ポリイミドは分子内に構造異方性の大き なベンゼン環やイミド環を多く含んでいるため、シリコ ン等の基板上で加熱製膜した場合に生じる熱応力により ポリイミド分子が面内に配向し、複屈折が大きく異なる という特徴を有している。この複屈折の大きさはポリイ ミドの分子構造に大きく依存する。通常、屈折率の大き く異なるポリイミドではその分子構造も異なるために、 その複屈折の大きさも異なる。特開平4-8734号公 報に示されたポリイミド共重合体はシリコン基板上でポ リイミド共重合体薄膜を作製した場合に光通信波長とな る波長1. 3μmにおいて共重合比を変えることでητε の値を1.523から1.614の範囲で制御すること が可能であるが、共重合比を変えることで同時にその複 屈折も0.008から0.123まで大きく変化する。 種々の光学部品の中で特にシングルモード光導波路やシ ングルモード光ファイバを作製するためには屈折率を精 密に制御した2種類の材料をコアとクラッドに用いるこ とが必要となるが、上記ポリイミド共重合体を材料とし て用いる場合にはコア材料とクラッド材料の複屈折が異 なるためにその偏波方向に対する光損失等の光導波特性 に相違が生じるという問題があった。

6

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は従来の 基板上に作製したポリイミド光導波路では有していなか った、コアとクラッドの屈折率差が基板面に平行な方向

の光と基板面に垂直な方向の光の間で同程度になるようなポリイミド共重合体を用いて、偏波方向に対する光損 失等の光導波特性の相違が小さいという特性を有する基 板上のポリイミド光導波路を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明の第1の発明は基板上に積層したコア層とクラッド 層からなる光導波路に関する発明であり、上記コア層及 びクラッド層がポリイミドであって、このポリイミドの 基板面と平行な方向の屈折率 (nte) と基板面に垂直な 10 方向の屈折率 (ntm) の差 (nte-ntm) の相違が、波 長1. 3μmにおいて0.003以下であるポリイミド から構成されることを特徴とする。また、本発明の第2 の発明は基板上に積層したコア層とクラッド層からなる 光導波路に関する発明であり、コア層又はクラッド層の どちらか一方が、2種類以上のポリイミドの共重合体で あって、nre-nrmの相違が共重合比によらず波長1. 3μmにおいて0.003以下であるポリイミドとポリ イミド共重合体から構成されることを特徴とし、更にポ リイミド共重合体の共重合比を変化させることでコアと クラッドの間の屈折率差を制御することを特徴とする。 また、本発明の第3の発明は基板上に積層したコア層と クラッド層からなる光導波路に関する発明であり、コア 層及びクラッド層が共に2種類以上のポリイミドの共重 合体であって、かつ n τ ε - n τ μ の相違が共重合比によら ず波長1. 3μmにおいて0. 003以下であるポリイ ミド共重合体から構成されることを特徴とし、更にその*

*共重合比を変化させることでコアとクラッドの間の屈折 率差を制御することを特徴とする。また、本発明の第4 の発明は基板上に積層したコア層とクラッド層からなる 光導波路に関する発明であって、第2、又は第3の発明 のポリイミド共重合体が下記一般式(化1):

[0005]

【化1】

【0006】及び下記一般式(化2):

[0007]

【化2】

【0008】で表される繰り返しからなるポリイミド共 重合体においてR1及びR2がそれぞれ下記式(化

3):

[0009]

【化3】

$$R_1$$
 if F_3 C

$$R_2$$
 th SO_2 SO_2

【0010】で表される繰り返しからなるポリイミドの 共重合体であることを特徴とする。また本発明の第5の 発明は基板上に積層したコア層とクラッド層からなる光 導波路に関する発明であって、第2、又は第3の発明の ポリイミド共重合体が下記一般式(化4): 【0011】 【化4】

50

【0012】及び下記一般式(化5):

[0013]

【化5】

$$\begin{bmatrix}
0 & F & F & F & 0 \\
N & F & F & F & 0
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
0 & F & F & F & 0 \\
N & F & F & F & 0
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
0 & F & F & F & 0 \\
N & F & F & 0
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
0 & F & F & F & 0 \\
N & F & F & 0
\end{bmatrix}$$

【0014】で表される繰り返しからなるポリイミド共 重合体においてR3 及びR4 がそれぞれ下記式(化 6):

* [0015] 【化6】

Rgが -

10

【0016】で表される繰り返しからなるポリイミドの 共重合体であることを特徴とする。また本発明の第6の 発明は基板上に積層したコア層とクラッド層からなる光 導波路に関する発明であって、第2、又は第3の発明の はポリイミド共重合体が下記一般式(化7):

[0017] 【化7】

【0018】及び下記一般式(化8):

30※【化8】

[0019]

【0020】で表される繰り返しからなるポリイミドの 共重合体であることを特徴とする。また本発明の第7の 発明は基板上に積層したコア層とクラッド層からなる光 40

★ポリイミド共重合体が下記―般式(化9):

[0021]

【化9】

導波路に関する発明であって、第2、又は第3の発明の★

【0022】及び下記一般式(化10):

【化10】

[0023]

【0024】で表される繰り返しからなるポリイミドの 共重合体であることを特徴とする。

【0025】本発明者らは、種々の既存ポリイミド、及びポリイミドの共重合体についてその光透過性、屈折率、複屈折を評価した結果、複屈折の大きさが同等の2種類のポリイミド、及びそれらのポリイミドの共重合体や混合物が、優れた耐熱性や近赤外波長領域での優れた光透過性を有していることに加えて、共重合比や混合比に対する複屈折の大きさの依存性が小さくなることを見出した。

【0026】本発明者らは、光導波路の材料として用い るポリイミドの分子構造とそのポリイミドを用いて基板 上にポリイミド薄膜を作製した場合の屈折率(nte、及 びntw)、及び複屈折について種々検討した。その結 果、複屈折の大きさが同程度の2種類のポリイミド、又 は複屈折の大きさが同程度の2種類のポリイミドの共重 合体を光導波路のコア、及びクラッド材として用いるこ とで、基板面に平行な方向の光と基板面に垂直な方向の 光の間でコアとクラッドの屈折率差が同程度になるとい う特性を有する基板上のポリイミド光導波路を作製でき ることを明らかにした。更に、この光導波路のコアとク ラッドのどちらか一方、又は両方に用いるポリイミド を、複屈折の大きさが同程度の2種類のポリイミドの共 重合体とし、ポリイミド共重合体の共重合比を変えるこ とによりコアとクラッドの屈折率差を制御できることを 明らかにした。

【0027】本発明のポリイミド光導波路のコア及びクラッドに用いる2種類のポリイミドの例としては2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物(6FDB)と2,2'ービス(トリフルオロメチル)ー4,4'ージアミノビフェニル(TFDB)から合成されるポリイミド(6FDA/TFDB)と6FDAと4,4'ーオキシジアニリン(4,4'ーODA)から合成されるポリイミド(6FDA/4,4'ーODA)を挙げることができる。また、本発明に用いる2種類のポリイミドとして6FDA/TFDB又は6FDA/4,4'ーODAのどちらか一方を第1種類目のポリイミドとし、6FDA/TFD

Bの繰り返し単位が第一成分で6FDA/4, 4'-O DAの繰り返し単位が第二成分の共重合体を第2種類目 のポリイミドとすることもできる。更に、本発明に用い る2種類のポリイミドをそれぞれ前記共重合体の中から 10 選ばれた共重合比の相異なる共重合体とすることもでき る。このとき、共重合体は共重合比、すなわち合成時に 用いる合成原料 (6FDA、TFDB、4,4'-OD A) の中のTFDBと4、4′-ODAの仕込み比を変 えることで複屈折が大きく変化することなく、屈折率 (nte、及びntw) を特定の範囲で制御できる。ここで 示した2種類のポリイミドとそれらのポリイミド共重合 体はその共重合比(共重合比が1:0、及び0:1を含 む)によらず複屈折の変動が波長1.3μmにおいて 20 0.003以下であり、本明細書ではこのような一群の ポリイミド又はポリイミド共重合体を1種類の光導波路 材料系と定義する。したがって、本発明ではこの光導波 路材料系の中からコアとクラッドの材料を選択すること が特徴となるが、本発明のポリイミド光導波路の作製に 用いることができる光導波路材料系としては後記表1に 示す39種類の材料系を例に挙げることができる。表1 中、「材料系1」は原料の酸二無水物として6FDAを 用い、ジアミンとしてTFDBを用いて合成されるポリ イミド (6FDA/TFDB) を第1種類目のポリイミ ドとし、また酸二無水物として6FDAを用い、ジアミ ンとして4,4'-ODAを用いて合成されるポリイミ ド (6FDA/4, 4'-ODA) を第2種類目のポリ イミドとすることを示しており、先に説明した2種類の ポリイミドの例は「材料系1」の場合に当る。したがっ て、本発明のポリイミド光導波路では表1に示した第1 種類目のポリイミドと第2種類目のポリイミドの共重合 体ももちろん使用することができる。更に、本発明に用 いるポリイミドは共重合体の他に第1成分の単独重合体 のポリアミド酸溶液と第2成分の単独重合体のポリアミ ド酸溶液の混合物を経由したポリイミド混合物であって もよい。

[0028]

【表1】

14

		. 表 1			
	第1種類目			のポリイミド	
	酸二無水物	ジアミン	酸二無水物	ジアミン	
材料系 [6 F D A	4.4'-ODA	
材料系 2			OFDA	4. 4'-DDS02	
材料系 3	6FDA	TFDB	ODPA		
材料系 4			BTDA	TFDB	
材料系 5			10PBDA		
材料系 6				4. 4' <u>-MDA</u>	
材料系 7			6 F D A	4.4' -ODA	
材料系 8				4. 4'-DDS02	
材料系 9		4 FMPD	ODPA		
材料系10		4 PMPD	BTDA	TFDB	
材料系 1 1			1 O F B D A		
材料系 1 2	10FEDA			4. 4' -MDA	
材料系13			6 F D A	4. 4' -QDA	
材料系14				4, 4'-DDS02	
材料系15		8 FODA	ODPA		
材料系16			BTDA	TFDB	
材料系17			10FBDA		
材料系18			6 F D A	4. 4' -MDA	
材料系19				3, 3'-DDSO2	
材料系20		2.4'-ODA	ODPA	4.4' -ODA	
材料系21			10FBDA		
材料系22			6 F D A	3. 3'-DDS02	
材料系23	BFDA	3 F D A M	ODPA	4.4' -ODA	
材料系24			10 PBDA		
材料系25			6FDA	2.4'-ODA	
材料系26		3, 4' -ODA	l	4. 4' -ODA	
材料系27		3. 3'-DD802	ODPA		
材料系28	1				
材料系29	1 OF BDA	4. 4' -ODA	6FDA	4-BDAF	
材料系30	10707			3 FEDAM	
材料系31		APHF33	10 PEDA	4, 4' - 6 F	
材料系32	_	3, 4' - ODA		1	
材料系33	ļ	3 F B D A M	Į	4-BDAF	
材料系34	1	4, 4'-DD802			
材料系35	6 P D A		6FDA	3 F D A M	
材料系36		4.4'-6F		3 F E D A M	
材料系37		" " " " "		3.4'-ODA	
材料系38				4. 4'-DDS02	
材料系39	PMDA	TFDB	P3FDA	TFDB	

【0029】表1の記号の説明

2, 2ービス(3, 4ージカル 6FDA: ボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン二無水物

1, 4ービス(3, 4ージカル 10FEDA:

ボキシトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼ

ン二無水物

ODPA: 4, 4'-オキシジフタル酸無

水物

ピロメリット酸二無水物 PMDA:

3, 3', 4, 4'ーベンゾフ BTDA:

ェノンテトラカルボン酸二無水物

1-トリフルオロメチルー2, P3FDA:

3, 5, 6-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物

TFDB: 2, 2'ーピス(トリフルオロ

メチル) -4, 4′ -ジアミノビフェニル

テトラフルオローmーフェニレ 4 FMPD:

ンジアミン

ビス(2,3,5,6-テトラ 8 FODA:

フルオロー4ーアミノフェニル) エーテル

4, 4'-ODA: 4, 4'-オキシジアニリン

3, 4' -ODA: 3, 4'ーオキシジアニリン

2, 4' - ODA:2, 4'-オキシジアニリン

1、1-ビス(4-アミノフェ

3FDAM: ニル) -1-フェニル-2, 2, 2-トリフルオロエタ

[1, 1ーピス [4ー(4ーア 3 F E D A M: ミノフェノキシ)フェニル]-1-フェニルー2,2,

40 2-トリフルオロエタン〕

3. 3'-DDSO2:3, 3'-ジアミノジフェニル スルホン

4, 4'-DDSO2:4, 4'-ジアミノジフェニル スルホン

4, 4′ーメチレンジアニリン 4, 4' - MDA:2, 2ーピス [4ー (アミノフ 4 - BDAF:

ェノキシ)フェニル) ヘキサフルオロプロパン

2, 2-ビス (3-アミノー4 APHF33: ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン

2, 2ービス(4ーアミノフェ 50 4, 4'-6 F:

ニル) ヘキサフルオロプロパン

【0030】本発明者らはこれらのポリイミド、ポリイミド共重合体及び混合物の前駆体溶液を用いてシングルモード光導波路を作製することにより、その光導波路における光損失等の光導波特性の偏波方向に対する相違を低減できることを見出した。本発明のポリイミド光導波路の構造は、一般に製造されている基板上の光導波路と同様でよく、例えばスラブ型、リッジ型、埋め込み型等がある。光導波路のコア材とクラッド材に用いる共重合体の選択は、光の波長、使用用途に適した屈折率の差になるようにすればよい。

【0031】埋め込み型シングルモード光導波路の製造 方法について図1を参照しつつ説明する。すなわち図1 は本発明による埋め込み型光導波路の作製方法の一例を 示す工程図であって、符号1は基板、2は下部クラッド 層、3はコア層、4はコアパターンを形成するためのマ スク、5はレジスト層、6は上部クラッド層を意味す る。シリコン等の基板1の上に下部クラッド用のポリイ ミド共重合体の前駆体溶液をスピンコート等の方法によ り塗布し、これを加熱等により硬化して下部クラッド層 2を得る。次にこの上に下部クラッド層として用いたポ リイミド共重合体より屈折率が高く、複屈折が同程度の ポリイミド共重合体の前駆体溶液を下部クラッド層2を 形成したときと同様の方法により形成し、コア層3を得 る。次にこの上にコアパターンを形成するためのマスク 層4を形成する〔図1 (a)〕。マスクとしてはA1、 Ti等の金属、SiO2、スピンオングラス (SO G)、Si含有レジスト、感光性ポリイミド等を用いる ことができる。マスク層4をつけた後レジスト塗布、プ リベーク、露光、現像、アフターベークを行い、パター ニングされたレジスト層5を得る〔図1(b)〕。次に レジスト層により保護されていないマスク層をエッチン グにより除去した後〔図1 (c)〕、マスク層で保護さ れていないポリイミドをドライエッチングにより除去す る〔図1 (d)〕。マスク層4にSi含有レジストや感 光性ポリイミドを用いた場合にはフォトレジストを使用 する必要はない。次に残ったマスク層4をドライエッチ ングやはく離液を用いることにより除去する〔図1

(e)〕。更にこの上にコア層として用いたポリイミド 共重合体より屈折率が低く、複屈折が同程度のポリイミ ド共重合体の前駆体溶液を下部クラッド層2を形成した ときと同様の方法により形成し、上部クラッド層6を得 る〔図1(f)〕。以上の工程を経ることにより、TE モードでのコアとクラッドの屈折率差とTMモードでの コアとクラッドの屈折率差が同程度で、偏波方向に対す る光損失等の光導波特性の相違が小さなポリイミドシン グルモード光導波路を作製できる。

[0032]

【発明の実施の形態】引続いていくつかの実施態様を用 0℃で30分、更に350℃で1時間で加熱キュアしいて本発明を更に詳しく説明する。なお種々の高分子の 50 た。この操作によりシリコン基板上に膜厚2~50μm

16

組合せにより、また光導波路構造により数限りない本発 明の高分子フィルム光導波路が得られることは明らかで あり、本発明はこれらの実施態様のみに限定されるもの ではない。ポリイミドの構造の確認は赤外吸収スペクト ルにおけるカルボニル基の対称及び非対称伸縮振動によ る特性吸収から行った。測定はシリコン基板上のポリイ ミド膜を測定試料とし、基板に用いたシリコンウェハと 同じ仕様のシリコンウェハをリファレンスとして行っ た。また、熱分解温度は窒素気流下10℃/分の速度で 昇温した時の10wt%重量減少時の温度で示した。屈 折率 (птє、及びпти) はプリズムカップリング法を用 い、波長1. 3μ mで測定した値を示した。作製した光 導波路の損失は以下のようにして測定した。まず、入射 端より波長1.3μmのTE偏波光、又はTM偏波光を 通し、出射光の強度を測定した。この入射光と出射光の 強度の差を光導波路長で割り、単位長さ当りの光損失を

【0033】光導波路用ポリイミドの合成 光導波路材料系(1)

(6FDA/TFDB) : (6FDA/4, 4'-O)DA) = 0:1のポリイミドの合成〕三角フラスコに 4. 00g (20. 0mmol) の4, 4'-オキシジ アニリンと8.88g (20.0mmol) の2, 2-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロ プロパン二無水物、及びN、N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 73.0gを加えた。これを窒素雰囲気 下、室温で3日間かくはんし、粘度は約400ポアズの ポリアミド酸のDMAc溶液を得た。この溶液をシリコ ン基板上にスピンコーティングし、窒素雰囲気下で70 ℃で2時間、160℃で1時間、250℃で30分、更 に350℃で1時間で加熱キュアした。この操作により シリコン基板上に膜厚2~50μmのポリイミド膜が得 られた。得られたポリイミド膜の赤外吸収スペクトルを 測定したところ、1720、及び1790cm⁻¹にポリ イミドのイミド環のカルボニル基の対称及び非対称伸縮 振動に基づく鋭い吸収ピークが観測され、このことから ポリイミドが合成できていることを確認した。

【0034】〔(6FDA/TFDB):(6FDA/4,4'-ODA)=1:0のポリイミドの合成〕三角フラスコに6.40g(20.0mmol)の2,2'ービス(トリフルオロメチル)-4,4'ージアミノビフェニルと8.88g(20.0mmol)の2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物、及びDMAc86.6gを加えた。これを窒素雰囲気下、室温で3日間かくはんし、粘度は約250ポアズのポリアミド酸のDMAc溶液を得た。この溶液をシリコン基板上にスピンコーティングし、窒素雰囲気下で70℃で2時間、160℃で1時間、250℃で30分、更に350℃で1時間で加熱キュアした。この操作によりシリコン基板上に膜厚2~50μm

のポリイミド膜が得られた。得られたポリイミド膜の赤 外吸収スペクトルを測定したところ、1720、及び1 790cm⁻¹にポリイミドのイミド環のカルボニル基の 対称及び非対称伸縮振動に基づく鋭い吸収ピークが観測 され、このことからポリイミドが合成できていることを 確認した。

[0035] [(6FDA/TFDB): (6FDA/ 4, 4' - ODA) = 5:5 のポリイミド共重合体の合成〕窒素雰囲気下で三角フラスコに0.851g(4. 25 mmo 1) 04, 4' - x + y = y - 1.3 1061g(4.25mmol)の2,2'-ビス(トリフ ルオロメチル)-4,4′-ジアミノビフェニル、及び DMAc37.5gを加え、かくはんして4,4'-オ キシジアニリンと2, 2′-ビス(トリフルオロメチ ル)-4,4'-ジアミノビフェニルを完全に溶解し た。次にこの溶液に3.78g(8.50mmol)の 2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) ヘキサ フルオロプロパン二無水物を加えた。これを窒素雰囲気 下、室温で3日間かくはんし、粘度は約330ポアズの ポリアミド酸共重合体のDMAc溶液を得た。この溶液 20 をシリコン基板上にスピンコーティングし、窒素雰囲気 下で70℃で2時間、160℃で1時間、250℃で3 0分、更に350℃で1時間で加熱キュアした。この操 作によりシリコン基板上に膜厚2~50μmの均一なポ リイミド共重合体膜が得られた。得られた共重合体膜の 赤外吸収スペクトルを測定したところ、1720、及び 1790cm⁻¹にポリイミドのイミド環のカルボニル基 の対称及び非対称伸縮振動に基づく鋭い吸収ピークが観 測され、このことからポリイミド共重合体が合成できて いることを確認した。 * 30

* [0036] [(6FDA/TFDB): (6FDA/ 4, 4' - ODA) = 1:9~9:1のポリイミド共重 合体の合成〕上記5:5のポリイミド共重合体の合成に おける4, 4′ーオキシジアニリンと2, 2′ービス (トリフルオロメチル) -4、4′ -ジアミノビフェニ ルのモル比を種々に変えて、同様の操作を行い、種々の

18

ポリイミド共重合体を得た。これらの共重合体の生成は 作製したフィルムの赤外吸収スペクトルにおけるイミド 環の吸収バンドから確認した。

【0037】〔作製したポリイミドの熱分解温度、屈折 率、及び複屈折の評価〕これらのポリイミド膜の熱分解 温度を測定したところ、10wt%重量減少温度はすべ て534℃から569℃の範囲であった。また、波長 1. 3 μ m での屈折率を測定したところ n τ ε は 1. 5 6 7から1. 523、ntwは1. 562から1. 515の 範囲であり、これらのnteとntwは共重合比を変えるこ とで上記範囲内で任意にかつ±0.001以下の精度で 精密に制御することができた。更に共重合比を変えたと きの複屈折は0.008から0.008であり、その変 動は±0.001以下の範囲に収まっていた。

【0038】光導波路材料系(2)~(8)

光導波路材料系(1)の合成と同様にして、種々のジア ミンと酸二無水物から他の光導波路材料系 (2) ~

(8) を合成した。これらの材料がポリイミド、又はポ リイミド共重合体であることは作製したフィルムの赤外 吸収スペクトルにおけるイミド環の吸収バンドから確認 した。これらの光導波路材料の熱分解温度、屈折率制御 範囲、複屈折の変動範囲を表2に示した。

[0039]

【表2】

2

44 44	_	共重合体の第1成分		共重合体の第2成分		熱分解	屈折率 (手御範囲	検屈折の	
材料	系	酸二無水物	ジアミン	酸二氯水物	ジアミン	(C)	nrs	Птк	爱勤和 田	
光旁波路材料系	(1)	6 FDA	TFDB	6FDA	4.4'- ODA	534 - 569	1. 523 - 1. 566	1. 515 - 1. 558	0.008 - 0.008	
光學被路材料系	(2)	6 FDA	TFDB	6FDA	4, 4 '-00302	541 - 569	1. 523 - 1. 569	1. 515 - 1. 563	0.006 - 0.008	
光等波路材料系	(3)	10 P B D A	4 FMPD	6 FDA	44'-0DA	501 -534	1. 527 - 1. 586	1. 519 - 1. 558	0.008 - 0.008	
光带被路材料系	(4)	1 O P E D A	8FODA	6 FDA	44'-0DA	485 - 534	1. 523 - 1. 566	L 515 - 1. 558	0.008 - 0.008	
光導被路材料系	(5)	6 FDA	3 FDAM	6 FDA	24'-0DA	540 -547	L 544 - 1. 557	1. 539 - 1. 554	0.003 - 0.005	
光等波路材料系	(6)	6FDA	4 - B D A P	6 FDA	4, 4 '-DDS02	539 - 541	L 540 - L 569	1. 534 - 1. 563	0.006 - 0.008	
光導被路材料系	(7)	6 FDA	2.4'- ODA	6 FDA	3, 3 '-00802	534 - 547	L 557 - L 570	L 554 - L 567	0.003 - 0.003	
光導被路材料系	(8)	6 FDA	44'-6F	6 FDA	3,4'-0DA	542 - 566	L 515 - L 566	L 510 - 1. 562	0.005-0.005	
比較材料	来	6 FDA	24'-0DA	PMDA	44'-0DA	547 - 590	1.557 - 1.678	L 554 - L 601	0.003 - 0.077	

【0040】光導波路の作製

(1)~(8)の光導波路材料系の中から1つの光導波 路材料系を選択した。この光導波路材料系は2種類のポ リイミドとそれらのポリイミドの共重合体からなる。こ 50 クラッドに用いてシングルモード光導波路を作製した。

の光導波路材料系の中から共重合比(1:0、及び0: 1を含む)の異なる2種類のポリイミド又はポリイミド 共重合体の前駆体であるポリアミド酸溶液をコア、及び

[0041]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説 明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

【0042】実施例1

光導波路材料系 (1) の中から1種類のポリイミドと1 種類のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸 溶液を用いて埋め込み型光導波路を作製した。アルミニ ウム基板に(6FDA/TFDB): (6FDA/4, 4′-ODA) の共重合比が3:7のポリイミド共重合 体の前駆体であるポリアミド酸のDMAc15wt%溶 液をスピンコート法により塗布した。これを70℃で2 時間、160℃で1時間、250℃で30分、350℃ で1時間熱処理をして下部クラッド層を形成した。次に この下部クラッド層上に6FDA/4, 4'-ODAの ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸のDMAc15 wt%溶液をスピンコート法により塗布した。これを7 0℃で2時間、160℃で1時間、250℃で30分、 350℃で1時間熱処理をしてコア層を形成した。次に このコア層上に膜厚0. 3 μ mのアルミニウム層を蒸着 した。次にこのアルミニウム層上にポジ型フォトレジス トをスピンコート法により塗布した後約95℃でプリベ 一クを行った。次にパターン形成用のフォトマスクを超 髙圧水銀ランプを用いて紫外線を照射した後ポジ型レジ スト用の現像液を用いて現像した。その後135℃でポ ストベークを行った。これにより線幅8μmを有する直 線状のレジストパターンが得られた。次にアルミニウム のウエットエッチングを行い、レジストパターンをアル ミニウム層に転写した。更にパターンニングされたアル ミニウムをマスクとしてコア層のポリイミドをドライエ ッチングにより加工した。次にポリイミドの上層にある アルミニウムをエッチング液で除去した。更にこの上に 下部クラッド層と同じポリイミド共重合体の前駆体であ るポリアミド酸のDMAc15wt%溶液をスピンコー ト法により塗布した。この塗膜を70℃で2時間、16 0℃で1時間、250℃で30分、380℃で1時間熱 処理して上部クラッド層を形成した。最後に光導波路の 両端をダイシングソーで切り落として光の入出射端面を 形成した。このようにしてアルミニウム基板上に埋め込 み型シングルモード光導波路が得られた。この光導波路 に基板と平行な方向の偏波を入射した場合(水平偏光) の損失は0.5 d B/cm、基板と垂直な方向の偏光を 入射した場合(垂直偏光)の損失は0.5dB/cmで あった。

【0043】実施例2

光導波路材料系 (1) の中から2種類のポリイミド共重 合体の前駆体であるポリアミド酸溶液を用いて埋め込み 型光導波路を作製した。光導波路の下部クラッド、及び 上部クラッドの材料として(6FDA/TFDB): (6FDA/4, 4'-ODA) の共重合比が8:2の

Ac15wt%溶液を用い、また光導波路のコアの材料 として (6FDA/TFDB): (6FDA/4, 4' -ODA) の共重合比が5:5のポリイミド共重合体の 前駆体であるポリアミド酸のDMAc15wt%溶液を 用いて、実施例1と同様の操作を行い、埋め込み型シン グルモード光導波路を作製した。この光導波路の水平偏 光の損失は0.4 d B/c m、垂直偏光の損失は0.4

20

dB/cmであった。 【0044】実施例3

光導波路材料系(1)の中から1種類のポリイミドと1 種類のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸 溶液を用いて埋め込み型光導波路を作製した。光導波路 の下部クラッド、及び上部クラッドの材料として (6 F DA/TFDB) のポリイミドの前駆体であるポリアミ ド酸のDMAc15wt%溶液を用い、また光導波路の コアの材料として(6FDA/TFDB):(6FDA /4, 4′-ODA) の共重合比が7:3のポリイミド 共重合体の前駆体であるポリアミド酸のDMAc15w t%溶液を用いて、実施例1と同様の操作を行い、埋め 込み型シングルモード光導波路を作製した。この光導波 路の水平偏光の損失は0.4 d B/cm、垂直偏光の損 失は0.4dB/cmであった。

【0045】実施例4~10

表2に示した各光導波路材料系から2種類のポリイミド 又はポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸溶 液を用いて、実施例1と同様の操作を行うことにより、 埋め込み型シングルモード光導波路を作製した。この導 波路の光損失を後記表3に示す。

【0046】比較例1

表2の比較材料系に示す酸二無水物とジアミンを用い、 複屈折の変動範囲が大きなポリイミド、及びポリイミド 共重合体を合成した。これらの比較材料系の熱分解温 度、屈折率制御範囲、複屈折の変動範囲を表2に示す。 この結果より、この比較材料系の複屈折の変動範囲は実 施例に用いた光導波路材料系と比較して極めて大きかっ た。次にこの比較材料系の中から1種類のポリイミドと 1種類のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド 酸溶液を用いて埋め込み型光導波路を作製した。光導波 路の下部クラッド、及び上部クラッドの材料として(6 FDA/2, 4'-ODA) のポリイミドの前駆体であ るポリアミド酸のDMAc15wt%溶液を用い、また 光導波路のコアの材料として(PMDA/4,4'-O DA): (6FDA/2, 4'-ODA) の共重合比が 1:9のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド 酸のDMAc15wt%溶液を用いて、実施例1と同様 の操作を行い、埋め込み型光導波路を作製した。この光 導波路はコアとクラッドの複屈折が大きく異なるために 水平偏光の損失は0.5dB/cm、垂直偏光の損失は 2 d B/c m以上であった。本比較材料系においてコア ポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸のDM 50 に用いるポリイミド共重合体としてPMDA/4, 4'

22

-ODAの共重合比が5%より大きな共重合体を用いる ことにより垂直偏光の損失を低減することは可能であっ たが、これに伴って水平偏光の導波光がマルチモードと*

*なった。 【0047】

【表3】

表

実施例	作製に用いた 光導波路材料系	共重合体の第1成分		共重合体の第2成分		第1成分	第2成分	报 失 (dB/cm)	
	JOSEPH TER	酸二無水物	ジアミン	酸二無水物	ジアミン	クラッド	コア	水平偏光	郵度優光
実施例 1	(1)	6FDA	TFDB	6 F D A	44'- ODA	3:7	0:1	0.5	0. 5
実施例 2	(1)	6 FDA	TFDB	6 F D A	44'-ODA	8:2	5:5	0.4	0. 4
実施例3	(1)	6 FDA	TFDB	6 F D A	4.4'-ODA	1:0	7:3	0.4	0. 4
実施例 4	(2)	6 F D A	TFDB	6 F D A	4.4'-DDS02	3:7	0:1	0.5	0.8
実施例 5	(3)	10FBDA	4 FMPD	6 F D A	4.4'- O D A	1:0	6:4	0.5	0. 6
実施例 6	(4)	1 O F E D A	8FODA	6 F D A	44'- ODA	1:0	7:3	0.6	0. 7
実施例7	(5)	6FDA	3 F D A M	6 F D A	2,4'- O D A	1:0	0:1	0.5	0. 7
実施例8	(8)	6FDA	4 - B D A F	6 FDA	4, 4 '-DDS02	8:2	3:7	0.6	0.6
実施例 9	(7)	6FDA	2.4'- 0 D A	6 FDA	3. 3 '-DDS02	9:1	0:1	0.6	0, 6
実施例10	(8)	6FDA	44'-6F	6 FDA	3, 4 '- 0 D A	2:8	0:1	0.6	0. 7
比較例1	比較材料系	6 F D A	24'-0DA	PMDA	44'- ODA	1:0	9:1	0.5	2以上

[0048]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明のポリイミド光導波路はそのコア、及びクラッド材料の複屈折が同程度であるために、光損失等の光導波特性の偏波方向に対する相違が小さいことが明らかとなった。これにより本発明のポリイミド光導波路は種々の光部品の構成要素として幅広く適用できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

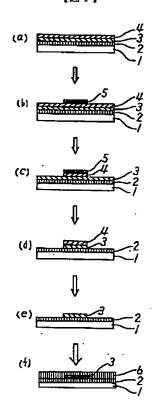
【図1】本発明による埋め込み型高分子光導波路の作製 方法を順に追って示した断面工程図である。

【符号の説明】

1:基板、2:下部クラッド層、3:コア層、4:コア パターンを形成するためのマスク、5:レジスト層、

6:上部クラッド層

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 安藤 慎治

東京都千代田区内奉町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社內

(72) 発明者 阪田 知巳

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72) 発明者 佐々木 重邦

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 小林 潤也

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内